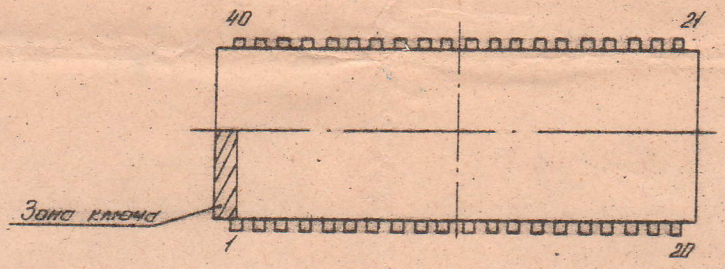
ЭТИКЕТКА

Микросхема КР1816ВЕ35 в пластмассовом корпусе, выполнена по полупроводниковой технологии на n-канальных МОП-транзисторах, предназначена для использования в качестве однокристальной микро-ЭВМ.

Схема расположения выводов



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1. Выходное напряжение высокого уровня сигналов данных (DB), В при I_{OH} = -100 мкА	U_{OH}	2,4	-
2. Выходное напряжение высокого уровня сигналов $\overline{RD}$, $\overline{WR}$, PME, ALE, В при I_{OH} = -100 мкА	U_{OH1}		
3. Выходное напряжение высокого уровня сигналов P1, P2, $\overline{PR}$, T0, В при I_{OH} = -40 мкА	U_{OH2}		
4. Выходное напряжение низкого уровня сигналов данных (DB), В при I_{OL} = 2,0 мА	U_{OL}	-	0,45
5. Выходное напряжение низкого уровня сигналов $\overline{RD}$, $\overline{WR}$, PME, ALE, В при I_{OL} = 1,8 мА	U_{OL1}		
6. Выходное напряжение низкого уровня сигнала $\overline{PR}$, В при I_{OL} = 1,0 мА	U_{OL2}		
7. Выходное напряжение низкого уровня сигналов P1, P2, T0, В при I_{OL} = 1,6 мА	U_{OL3}		
8. Входное напряжение высокого уровня, В	U_{IH}	2,0	U_{CC}
9. Входное напряжение высокого уровня сигналов BQ1, BQ2, $\overline{SR}$, В	U_{IH1}	3,8	
10. Входное напряжение низкого уровня, В	U_{IL}	-0,5	0,8
11. Входное напряжение низкого уровня сигналов BQ1, BQ2, $\overline{SR}$, В	U_{IL1}	-0,5	0,6
12. Входной ток, мкА при 0,45 В $\leq U_I \leq U_{CC}$	I_I	-500	-
13. Выходной ток в состоянии "Выключено", мкА при 0,45 В $\leq U_I \leq U_{CC}$	I_{OZ}	-10	10
14. Ток утечки на входах, мкА, при 0 В $\leq U_I \leq U_{CC}$	I_{LI}		
15. Ток потребления, мА	I_{CC}	50	115
16. Емкость входа/выхода, пФ	$C_{I/O}$	-	20
17. Входная емкость, пФ	C_I		10

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем

Золото 2-02 10 г

№ пп	Наименование цветного металла	Марка	Масса	Примечание
1.	Сплав никелевый	42Н	1,7 г	

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема КР1816ВЕ35 соответствует техническим условиям бК0.348.839 ТУ и бК0.348.839-04 ТУ.

conector.by